

Silizium-npn-Leistungsschaltransistor für Transverter, Schaltnetzteile und allgemeine Anwendung

Bauform 5 TO3

Wärmewiderstand $R_{thjc} \leq 2,5 \text{ K/W}$

Grenzwerte (gültig für den Betriebstemperaturbereich)

| | |
|--|-----------------|
| U_{CERM} ($R_{BE} \leq 100 \Omega$) | 900 V |
| U_{CEO} ($I_B = 0$) | 350 V |
| I_C | 2,5 A |
| I_{CM} | 3,0 A |
| I_{BM} | 2,5 A |
| P_{tot} (bei $\vartheta_c \leq 90^\circ\text{C}$) | 10 W |
| ϑ_j | -25 ... +115 °C |
| ϑ_a | -25 ... +100 °C |

Elektrische Kennwerte bei $\vartheta_c = 25^\circ\text{C} - 5 \text{ K}$

| | | |
|-------------|---|--------------------------|
| I_{CES} | ($U_{CESM} = 900 \text{ V}, U_{BE} = 0$) | ∇ 1,0 mA |
| U_{CEsat} | ($I_C = 1 \text{ A}, I_B = 0,2 \text{ A}$) | ∇ 3,0 V |
| U_{BEsat} | ($I_C = 1 \text{ A}, I_B = 0,2 \text{ A}$) | ∇ 1,5 V |
| t_{on} | ($I_C = 1 \text{ A}$) | ∇ 1 μs |
| t_{off} | ($I_B = 0,2 \text{ A}, -I_B = 0,4 \text{ A}$) | ∇ 5 μs |